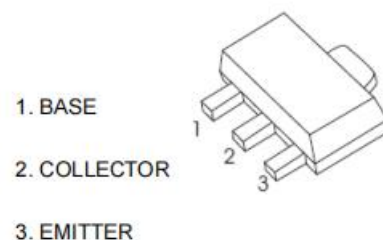


SOT-89 Bipolar Transistor 双极型三极管

■ Features 特点

NPN Low Saturation Voltage 低饱和压降



■ Absolute Maximum Ratings 最大额定值

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
Collector-Base Voltage 集电极基极电压	V_{CBO}	60	V
Collector-Emitter Voltage 集电极发射极电压	V_{CEO}	50	V
Emitter-Base Voltage 发射极基极电压	V_{EBO}	6	V
Collector Current 集电极电流	I_C	2000	mA
Power dissipation 耗散功率	$P_C(T_a=25^{\circ}\text{C})$	500	mW
Thermal Resistance Junction-Ambient 热阻	$R_{\theta JA}$	250	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Junction and Storage Temperature 结温和储藏温度	T_J, T_{stg}	-55to+150 $^{\circ}\text{C}$	

■ Device Marking 产品打标

H_{FE}	82-180(P)	120-270(Q)	180-390(R)
Mark	DKP	DKQ	DKR

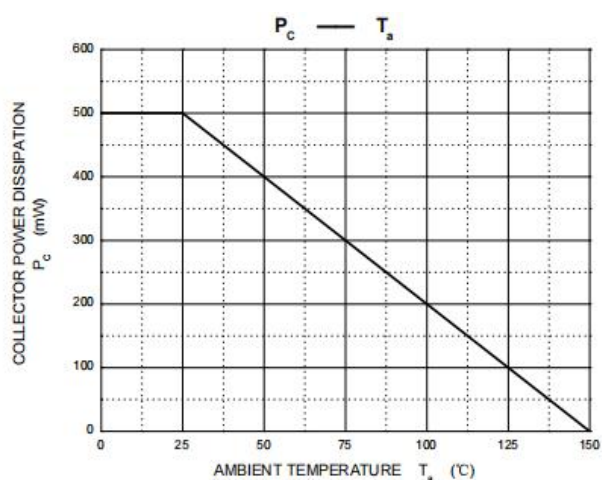
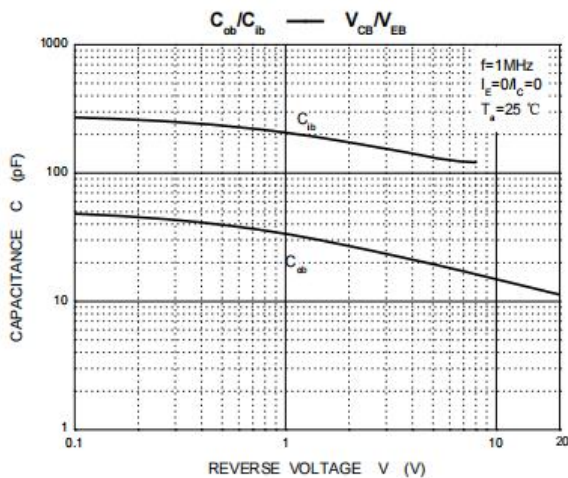
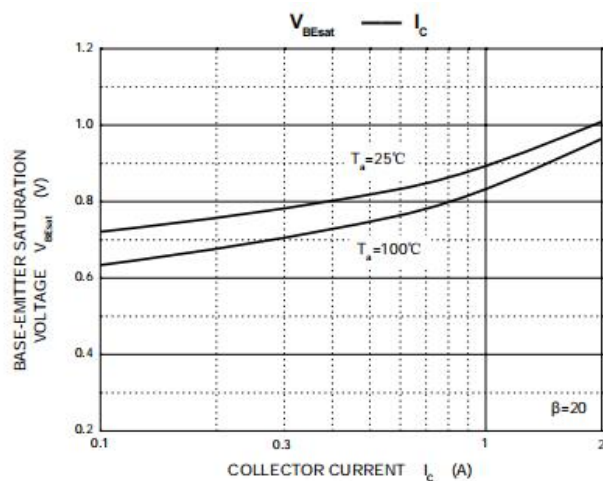
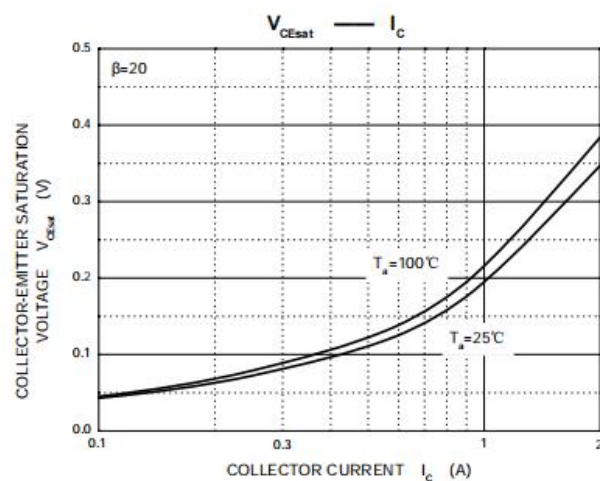
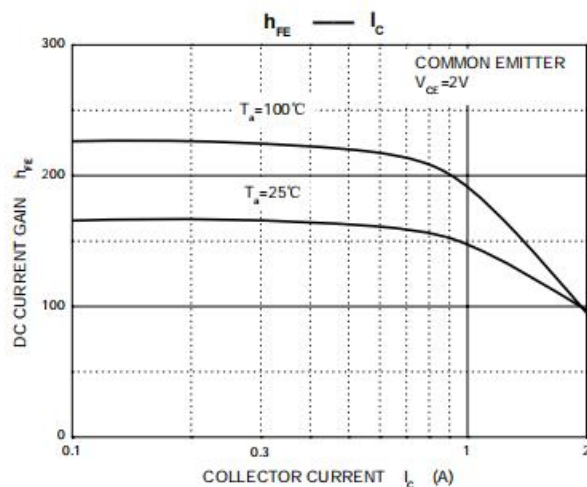
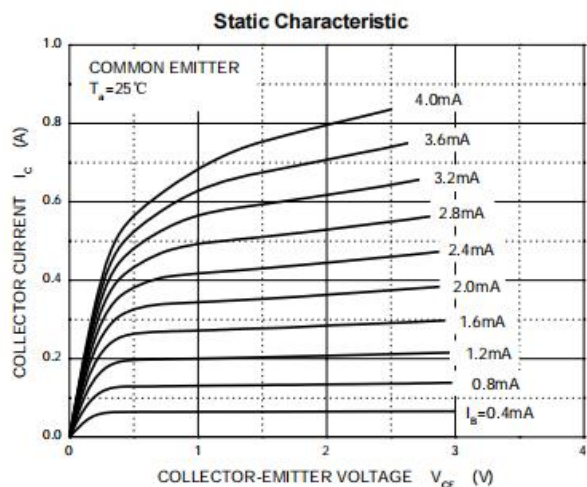
Electrical Characteristics 电特性

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极基极击穿电压 ($I_C=50\mu\text{A}$, $I_E=0$)	BV_{CBO}	60	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极发射极击穿电压 ($I_C=1\text{mA}$, $I_B=0$)	BV_{CEO}	50	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极基极击穿电压 ($I_E=50\mu\text{A}$, $I_C=0$)	BV_{EBO}	6	—	—	V
Collector-Base Leakage Current 集电极基极漏电流 ($V_{CB}=60\text{V}$, $I_E=0$)	I_{CBO}	—	—	100	nA
Emitter-Base Leakage Current 发射极基极漏电流 ($V_{EB}=5\text{V}$, $I_C=0$)	I_{EBO}	—	—	100	nA
DC Current Gain 直流电流增益 ($V_{CE}=2\text{V}$, $I_C=500\text{mA}$)	H_{FE}	82	—	390	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极发射极饱和压降 ($I_C=1000\text{mA}$, $I_B=50\text{mA}$)	$V_{CE(sat)}$	—	—	350	mV
Base-Emitter Saturation Voltage 基极发射极饱和压降 ($I_C=1000\text{mA}$, $I_B=50\text{mA}$)	$V_{BE(sat)}$	—	—	1000	mV
Transition Frequency 特征频率 ($V_{CE}=2\text{V}$, $I_C=500\text{mA}$)	f_T	—	210	—	MHz
Output Capacitance 输出电容 ($V_{CB}=10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$)	C_{ob}	—	25	—	pF

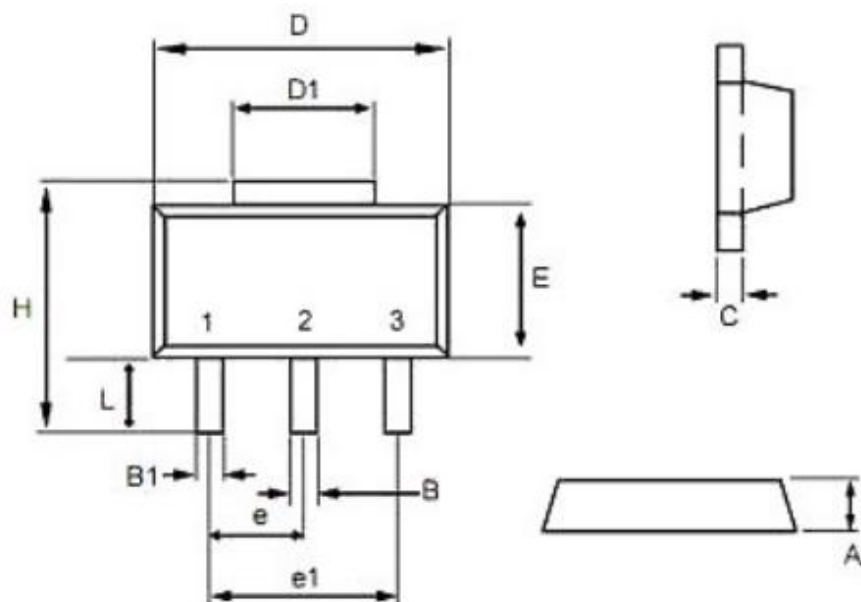


■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线





■Dimension 外形封装尺寸



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.40	1.60	0.055	0.063
B	0.40	0.56	0.016	0.022
B1	0.35	0.48	0.014	0.019
C	0.35	0.44	0.014	0.017
D	4.40	4.60	0.173	0.181
D1	1.35	1.83	0.053	0.072
e	1.45	1.55	0.057	0.061
e1	2.95	3.05	0.116	0.120
E	2.29	2.60	0.090	0.102
H	3.75	4.25	0.148	0.167
L	0.80	1.20	0.031	0.047

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT](#) *category:*

Click to view products by [Yongyutai Electronics](#) *manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE16](#) [NTE195A](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC4731T-AY](#) [2SC5488A-TL-H](#) [FMC5AT148](#) [2N2369ADCSM](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2SB1324-TD-E](#) [2SC5231C8-TL-E](#) [CPH6501-TL-E](#) [BULD128DT4](#) [CPH6021-TL-H](#) [MCH6102-TL-E](#) [2N3879](#) [30A02MH-TL-E](#) [NTE13](#) [NTE282](#) [NTE350](#) [NTE81](#) [JANSR2N2907AUB](#) [JANSR2N2222AUB](#) [CMLT3946EG TR](#) [SNSS40600CF8T1G](#) [CMLT3906EG TR](#) [GRP-DATA-JANS2N2907AUB](#) [GRP-DATA-JANS2N2222AUA](#) [MMDT3946FL3-7](#) [2N4240](#) [JANS2N3019](#) [MSB30KH-13](#) [2N2221AUB](#) [2SD1815T-TL-E](#) [Jantxv2N3810](#) [2N6678](#) [2N2907Ae4](#) [2N3963](#) [50C02MH-TL-E](#) [Jantx2N5415](#) [CPH3123-TL-E](#) [SMBT35200MT1G](#) [SMMJT350T1G](#) [NSVDTA113EM3T5G](#) [MBT3904DW1T1H](#)